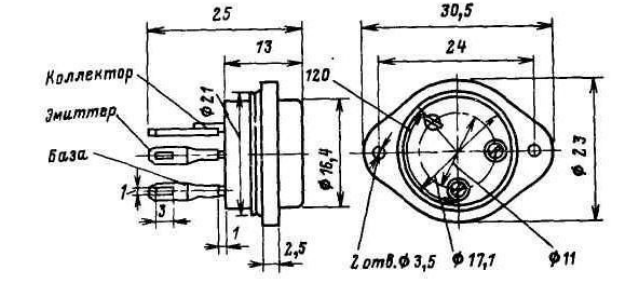


**П216, П216А, П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217, П217А, П217Б, П217В, П217Г**

Транзисторы германиевые сплавные р-п-р универсальные низкочастотные мощные  
 Предназначены для применения в схемах переключения, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях постоянного напряжения  
 Выпускаются в металлоглазном корпусе с жесткими выводами  
 Обозначение типа приводится на корпусе  
 Масса транзистора не более 12,5 г, крепежного фланца не более 4,5 г



**Электрические параметры**

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: при  $I_K = 4$  А,  $I_B = 0,5$  А не более:

П216, П216А	0,75 В
П217, П217А, П217Б, П217Г	1,0 В

при  $I_K = 2$  А,  $I_B = 0,3$  А П216Б, П216В, П216Д, П217В не более: 0,5 А

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_K = 3,5$  А,  $I_B = 0,5$  А:

П216, П217 не более	1,5 В
П217Б	0,6-0,9 В
П217 не более	0,8 В

Обратный ток коллектора не более:

при  $T = 293$  К:

при $U_{КЭ} = 35$ В:	
П216Б	1,5 мА
П216В	2 мА
при $U_{КЭ} = 40$ В П216, П216А	0,5 мА
при $U_{КЭ} = 50$ В:	
П216Г	2,5 мА
П216Д	2 мА
при $U_{КЭ} = 60$ В:	
П217, П217А, П217Б	0,5 мА
П217В, П217Г	3 мА
при $T = 343$ К:	
при $U_{КЭ} = 35$ В П216Б, П216В	7,5 мА
при $U_{КЭ} = 40$ В П216, П216А	4,5 мА
при $U_{КЭ} = 50$ В П216Г, П216Д	7,5 мА
при $U_{КЭ} = 60$ В:	
П217, П217А, П217Б	5 мА
П217В, П217Г	7,5 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер при  $I_B = 0$  не более:

при $U_{КЭ} = 30$ В П216, П216А	40 мА
при $U_{КЭ} = 45$ В П217, П217А, П217Б	50 мА

Обратный ток коллектор-эмиттер при  $R_{БЭ} = 0$  не более

при $U_{КЭ} = 35$ В П216Б, П216В	20 мА
при $U_{КЭ} = 50$ В	
П216Г	50 мА
П216Д	20 мА
при $U_{КЭ} = 60$ В П217В, П217Г	20 мА

Обратный ток эмиттер-база при  $U_{ЭБ} = 15$  В не более при  $T = 293$  К

П216, П216А, П217, П217А, П217Б	0,4 мА
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г	0,75 мА

при  $T = 343$  К

П216, П216А, П217, П217А, П217Б	4 мА
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г	7 мА

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме малого сигнала при  $U_{КЭ} = 5$  В,  $I_K = 1$  А

П216А	20-80
П217А	20-60
П217Б не менее	20

при  $U_{КЭ} = 3$  В,  $I_K = 2$  А

П216Б не менее	10
П216В не менее	30
П216Г не менее	5
П216Д	15-30
П217Г	15-40

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером

при $U_{КЭ} = 0,75$ В, $I_K = 4$ А П216 не менее	18
при $U_{КЭ} = 1$ В, $I_K = 4$ А П217 не менее	15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при  $U_{КБ} = 10$  В,  $I_K = 0,1$  А не менее: 100 кГц

Плавающее напряжение эмиттера не более

при $U_{КБ} = 35$ В П216Б, П216В	0,5 В
при $U_{КБ} = 40$ В П216, П216А	0,3 В
при $U_{КБ} = 50$ В П216Г, П216Д	0,5 В
при $U_{КБ} = 60$ В	
П217, П217А, П217Б	0,3 В
П217В, П217Г	0,5 В

**Предельные эксплуатационные данные**

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при  $R_{БЭ} = 0$

П216Б, П216В	35 В
П216, П216А	40 В
П216Г, П216Д	50 В
П216, П217А, П217Б, П217В, П217Г	60 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $I_B = 0$

П216, П216А	30 В
П217, П217А, П217Б	45 В

Постоянное напряжение эмиттер-база: 15 В

Постоянный ток коллектора: 7,5 А

Постоянный ток базы: 0,75 А

Постоянная рассеиваемая мощность при  $T_K \leq 298$  К

П216, П216А, П217, П217А, П217Б	30 Вт
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г	24 Вт

при  $T_K = 343$  К

П216, П216А, П217, П217А, П217Б	7,5 Вт
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г	6 Вт

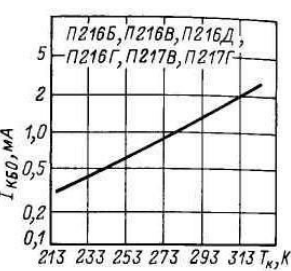
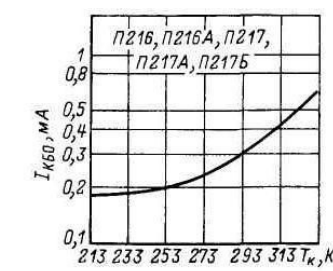
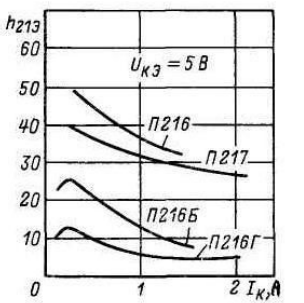
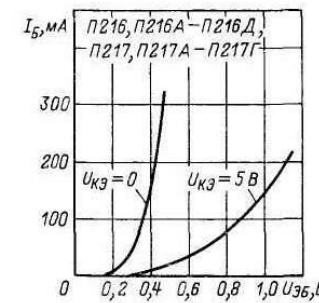
Температура перехода: 358 К

Тепловое сопротивление переход-корпус

П216, П216А, П217, П217А, П217Б	2 К/Вт
П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г	2,5 К/Вт

Температура окружающей среды: От 213 до  $T_K = 343$  К

Примечание При эксплуатации транзистор с помощью накладного фланца должен быть жестко закреплен на металлическом шасси или на специальном теплоотводе со шлифованной поверхностью. Перед креплением транзистора контактирующие поверхности рекомендуется смазывать невывсыхающим маслом. Диаметр отверстия в теплоотводе под выводы транзистора должен быть не более 5 мм. При необходимости электрической изоляции корпуса (коллектора) транзистора от шасси или тепловода между транзистором и теплопроводом рекомендуется ставить прокладку из оксидированного алюминия или слюды. Суммарное тепловое сопротивление между переходом и теплопроводом увеличивается на 0,5 К/Вт на каждые 50 мкм слюдяной прокладки или на 0,25 К/Вт на каждые 50 мкм слоя окиси алюминия.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.

Зависимость обратного тока коллектора от напряжения коллектор-база.

Зависимость обратного тока коллектора от температуры корпуса.

Зависимость обратного тока коллектора от температуры корпуса.

Пайка к выводам транзистора допускается только на их плоской части. При пайке цилиндрическая часть вывода должна быть зажата теплопроводящими губками. Изгиб выводов допускается только на их плоской части.